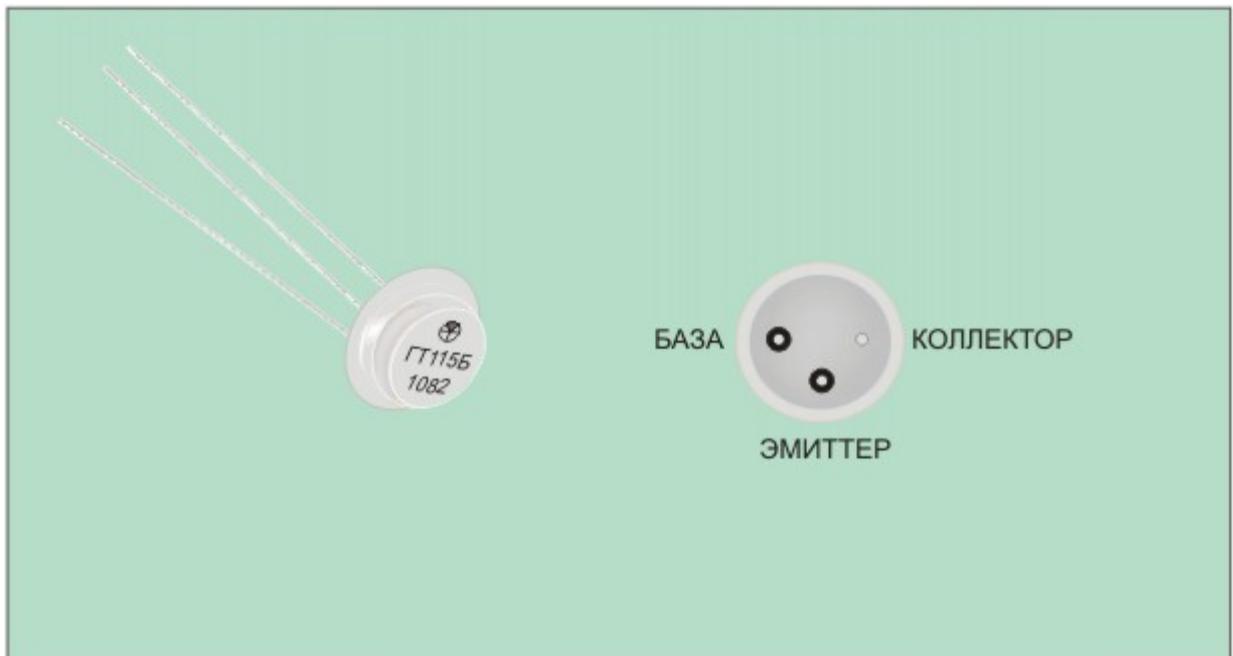


Транзисторы ГТ115А, ГТ115Б, ГТ115В, ГТ115Г, ГТ115Д.

Транзисторы **ГТ115** - германиевые, усилительные маломощные низкочастотные, структуры р-п-р.

Корпус металлостеклянный с гибкими выводами. Масса - около 0,6 г. Маркировка буквенно - цифровая, сверху корпуса.



Наиболее важные параметры.

Коэффициент передачи тока у транзисторов ГТ115А, ГТ115Б - от **20** до **80**, у ГТ115В, ГТ115Г находится в пределах от **60** до **150**.

У транзисторов ГТ115А, ГТ115Б - от **20** до **80**

Максимальное напряжение эмиттер-база - **20в**.

Максимальное напряжение коллектор - база :

У транзисторов ГТ115А, ГТ115В, ГТ115Д - **20в**.

У транзисторов ГТ115Б, ГТ115Г - **30в**.

Предельная частота коэффициента передачи тока ($f_{h21э}$) транзистора для схем с общим эмиттером: До **1 МГц**.

Максимальный ток коллектора - **30 мА**.

Обратный ток коллектора при напряжении коллектор-база 20в и температуре окружающей среды от -60 до +25 по Цельсию: У транзисторов ГТ115А, ГТ115В, ГТ115Д не более - **40 мкА**.

У транзисторов ГТ115Б, ГТ115Г не более - **40 мкА**.

Рассеиваемая мощность коллектора - 50мВт.